

# 深圳市丽晶微电子科技有限公司

SHEN ZHEN ELITE CHIP MICROCIRCUIT CO., LTD

## EH211020-9EBD-4A70 超低功耗开关芯片

### 一. 功能说明

三路按键输入控制两路电平信号同步输出（二选一），上电不工作 OUTL 为高电平，OUTH 为低电平。

KEY1 键：长按 1 秒开机 OUTL 输出低电平，OUTH 输出高电平，再长按 1 秒关机。

KEY2 键：长按 2 秒开机 OUTL 输出低电平，OUTH 输出高电平，再长按 2 秒关机。

KEY3 键：长按 3 秒开机 OUTL 输出低电平，OUTH 输出高电平，再长按 3 秒关机。

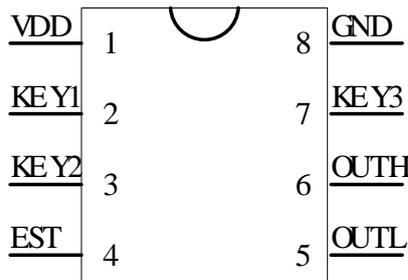
### 二. 极限参数

Supply voltage (Vdd).....	- 0.3V ~ 6.0V
Input in voltage (Vin).....	V <sub>SS</sub> - 0.2V ~ V <sub>DD</sub> + 0.2V
Operating ambient temperature (Topr) .....	-20°C ~ + 85°C
Storage ambient temperature (Tstor) .....	- 40°C ~ + 125°C

### 三. 电气参数 (VDD=5.0V TA=25°C)

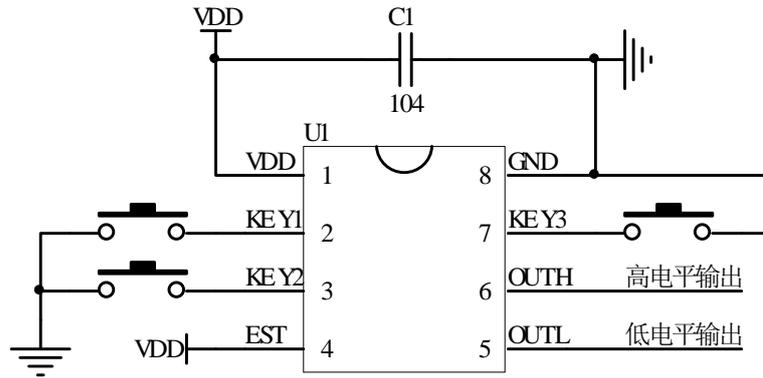
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
工作电压	VDD	2.2	3.0	5.0	V	$F_{cpu} = 1MHz$
工作电流	IOP		2		uA	V <sub>DD</sub> = 3V, 4Mhz
静态电流	ISTB		2		uA	V <sub>DD</sub> =3V, ILRC 16Khz
驱动电流低电平输出	IOL	8	15		mA	V <sub>DD</sub> =5.0V, V <sub>OP</sub> =V <sub>SS</sub> +0.5V
驱动电流高电平输出	IOH	8	15		mA	V <sub>DD</sub> =5.0V, V <sub>OP</sub> =V <sub>DD</sub> -0.5V
过 VDD 极限电流	IVDD <sub>max</sub>			50	mA	
过 GND 极限电流	IGND <sub>max</sub>			50	mA	
工作温度	TA	-20	25	85	°C	
储存温度	Tstg	-40	25	125	°C	

### 四. 封装脚位图 (SOP-8)

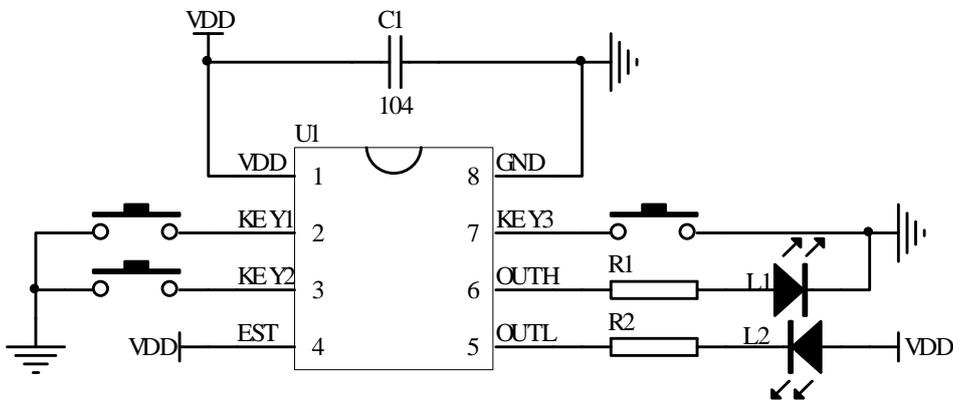


管脚号	符号	功能描述
1	VDD	电源正
2	KEY1	长按 1 秒开关键
3	KEY2	长按 2 秒开关键
4	EST	外部上拉 VDD
5	OUTL	LED 输出，低电平有效
6	OUTH	LED 输出，高电平有效
7	KEY3	长按 3 秒开关键
8	GND	电源负

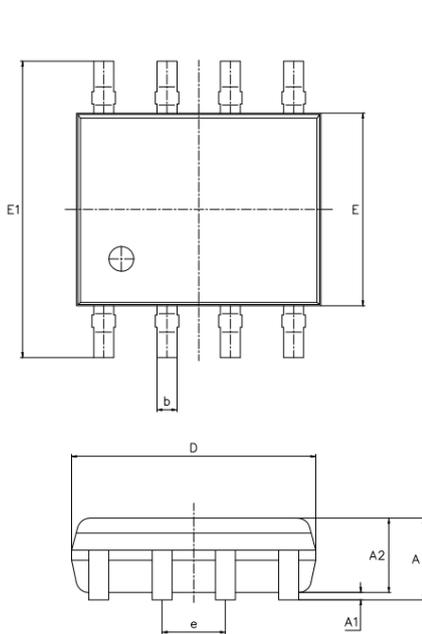
### 五. 电路图参考



### 接 LED 应用图



### 六. 封装尺寸图 (SOP-8)



Symbol	Dimensions in millimeters		Dimensions in inches	
	min	max	min	max
A	1.4000	1.7000	0.0550	0.0670
A1	0.0500	0.1500	0.0020	0.0060
A2	1.3500	1.5500	0.0530	0.0610
b	0.3060	0.5060	0.0150	0.0170
c	0.1700	0.2500	0.0070	0.0100
D	4.7000	5.1000	0.1850	0.2000
E	3.8750	3.9250	0.1530	0.1550
E1	5.8000	6.2000	0.2280	0.2440
e	1.2700±0.13		0.0500±0.005	
L	0.6150	0.7650	0.0240	0.0300
L1	1.0250±0.2		0.0404±0.007	
L1-L1'	-	0.12	-	0.005
θ	0° 8°		0° 8°	

### 七. 版本说明

版本	日期	描述
EH211020-9E88-569E	2021/10/22	V01 初版
EH211020-9EBD-4A70	2021/11/5	V02 升级程序